

高功率微波

用MEI方法研究脉冲线源辐射问题

[廖成<sup>1</sup>](#) [蒙林<sup>2</sup>](#) [鄢扬<sup>2</sup>](#)

(. 西南交通大学 电磁所, 四川 成都 610031; 2. 电子科技大学 高能电子学研究所, 四川 成都 610054)

摘要: 脉冲线电流源的辐射问题是研究高功率微波辐射、传播和散射问题的基础。用时域有限差分方法结合时域MEI吸收边界条件来对该问题进行求解, 通过与不同种类边界条件配合得出的数值解的比较可以证明, 利用时域MEI方法的一阶吸收边界条件对线源辐射问题进行处理时, 可以使截断边界离源更近, 从而减少了计算量, 并达到提高计算精度的目的。

关键词: [脉冲辐射](#) [FDTD方法](#) [MEI方法](#)

通信作者:

相关文章([脉冲辐射](#)):

[高功率半抛物面冲击脉冲辐射天线系统实验研究](#)

[线框馈电抛物反射面高功率电磁脉冲辐射天线](#)

[用MEI方法研究脉冲线源辐射问题](#)

[超宽谱电磁脉冲辐射场测量系统](#)

[\[PDF全文\]](#)

[\[HTML摘要\]](#)

[发表评论](#)

[查看评论](#)